

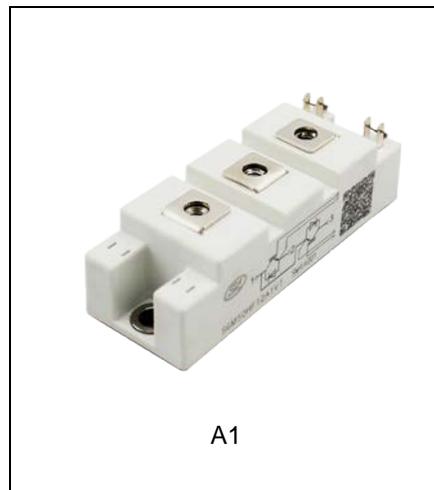
75A, 1200V IGBT模块

描述

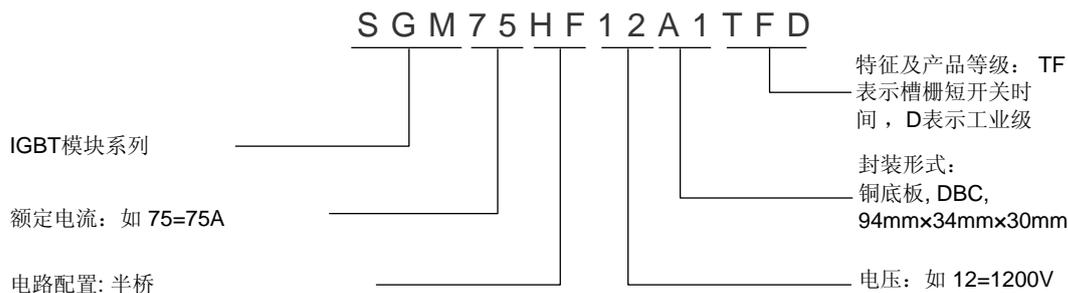
SGM75HF12A1TFD 模块性能优良, 适用于不间断电源, 交流变频驱动器、电焊机等 (开关频率 20KHz 以上)。

主要特点

- ◆ 75A, 1200V, $V_{CE(sat)}(\text{典型值}) = 2.1V @ I_C = 75A$
- ◆ $V_{CE(sat)}$ 带正温度系数
- ◆ 高抗短路能力
- ◆ 低开关损耗
- ◆ 绝缘铜底板, 采用 DBC 技术



命名规则



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	包装
SGM75HF12A1TFD	A1	SGM75HF12A1TFD	纸箱

极限参数(除非特殊说明, $T_c=25^\circ\text{C}$)

参 数	符号	参 数 范 围	单 位
集电极-发射极电压	V_{CE}	1200	V
栅极-发射极电压	V_{GE}	± 20	V
集电极电流	$T_c=80^\circ\text{C}$ I_C	75	A
集电极重复脉冲电流	$T_c=80^\circ\text{C}$ I_{CRM}	150	A
工作结温范围	T_J	-40~+175	$^\circ\text{C}$
储存温度范围	T_{stg}	-40~+125	$^\circ\text{C}$
隔离电压	V_{iso}	2500	V
散热器 M6	M_s	3~5	Nm
接线端 M5	M_t	2.5~5	Nm
重量	W	160	g

热阻特性

参 数	符号	参数范围	单位
结-壳热阻 (单个IGBT)	$R_{\theta JC}$	0.35	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
结-壳热阻 (单个FRD)	$R_{\theta JC}$	0.48	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
结-环境热阻	$R_{\theta CS}$	0.03	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

IGBT 电气特性参数 (除非特殊说明, $T_C=25^{\circ}\text{C}$)

参 数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集电极-发射极击穿电压	BV_{CE}	$V_{GE}=0\text{V}, I_C=0.25\text{mA}$	1200	--	--	V
集电极-发射极漏电流	I_{CES}	$V_{CE}=1200\text{V}, V_{GE}=0\text{V}, T_C=25^{\circ}\text{C}$	--	--	20	μA
		$V_{CE}=1200\text{V}, V_{GE}=0\text{V}, T_C=125^{\circ}\text{C}$	--	--	50	μA
栅极-发射极漏电流	I_{GES}	$V_{GE}=\pm 20\text{V}, V_{CE}=0\text{V}$	-200	--	200	nA
栅极阈值电压	$V_{GE(th)}$	$I_C=250\mu\text{A}, V_{CE}=V_{GE}$	5.0	5.6	7.0	V
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE(sat)}$	$I_C=75\text{A}, V_{GE}=15\text{V}, T_C=25^{\circ}\text{C}$	--	2.1	2.5	V
		$I_C=75\text{A}, V_{GE}=15\text{V}, T_C=125^{\circ}\text{C}$	--	2.3	2.7	
输入电容	C_{ies}	$V_{CE}=30\text{V}$	--	4860	--	pF
输出电容	C_{oes}	$V_{GE}=0\text{V}$	--	770	--	
反向传输电容	C_{res}	$f=1\text{MHz}$	--	340	--	
内置栅极电阻	r_G		--	10	--	Ω
导通延迟时间	$T_{d(on)}$	$V_{CE}=600\text{V}$ $I_C=75\text{A}$ $R_g=35\Omega$	--	150	--	ns
上升时间	T_r		--	123	--	
关断延迟时间	$T_{d(off)}$		--	592	--	
下降时间	T_f		--	142	--	
导通损耗	E_{on}	$V_{GE}=15\text{V}$	--	14.2	--	mJ
关断损耗	E_{off}	感性负载	--	3.8	--	
总开关损耗	E_{st}		--	18	--	
栅极电荷	Q_g	$V_{CE} = 600\text{V}, I_C=75\text{A},$ $V_{GE} = -8\sim 15\text{V}$	--	548	--	nC
栅极-发射极电荷	Q_{ge}		--	143	--	
栅极-集电极电荷	Q_{gc}		--	287	--	

FRD 电气特性参数 (除非特殊说明, $T_C=25^{\circ}\text{C}$)

参 数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
二极管正向电压	V_F	$I_F=75\text{A}, T_C=25^{\circ}\text{C}$	--	1.66	--	V
		$I_F=75\text{A}, T_C=125^{\circ}\text{C}$	--	1.59	--	
二极管反向恢复时间	T_{rr}	$I_f = 75\text{A}, di/dt=730\text{A}/\mu\text{s}$	--	132	--	ns
二极管反向恢复电流	I_{RM}		--	57	--	A
二极管反向恢复电荷	Q_{rr}		--	4.0	--	μC

典型特性曲线

图1. 典型输出特性 (25°C)

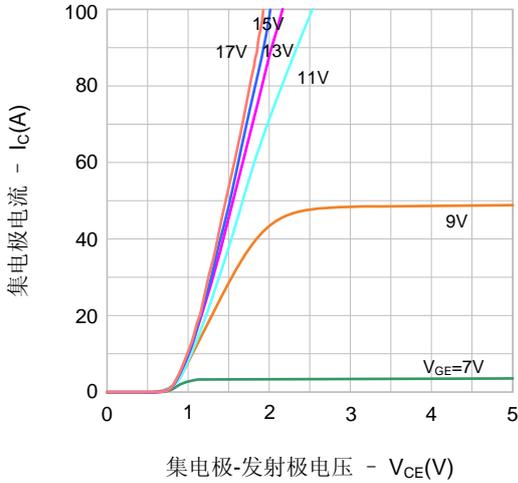


图2. 典型输出特性(125°C)

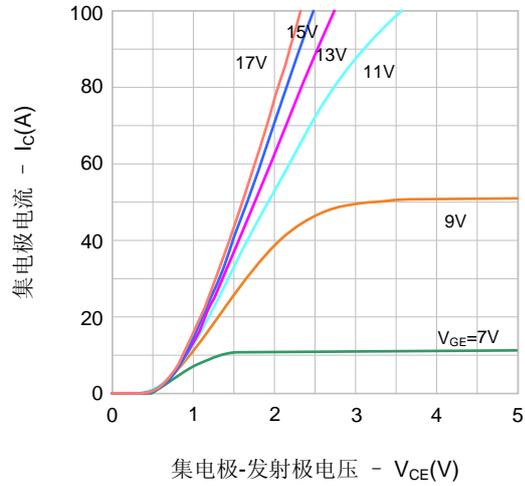


图3. 传输特性

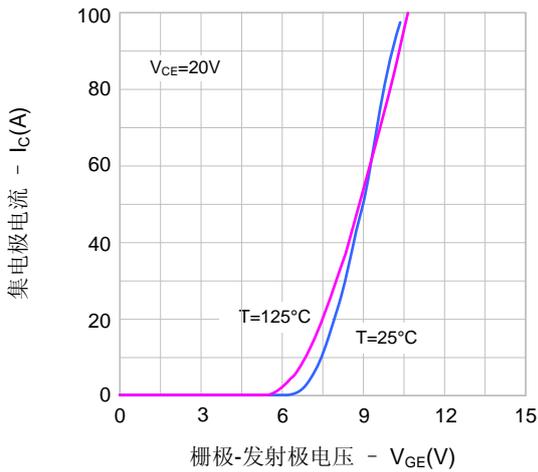


图4. 电容特性

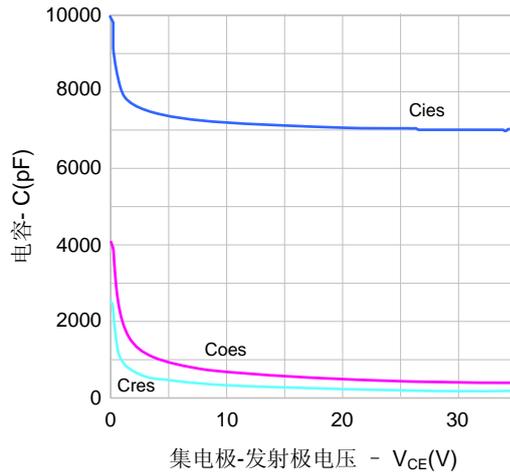


图 5. 栅极电荷特性

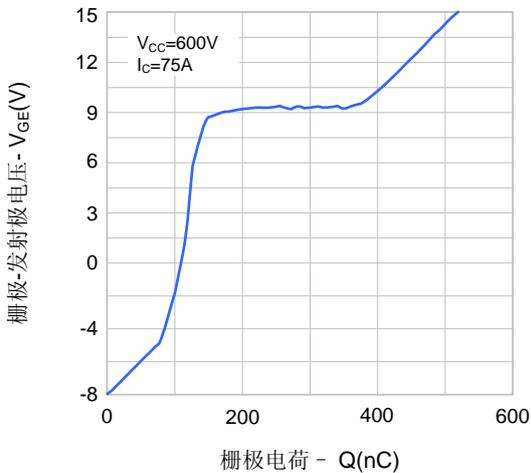
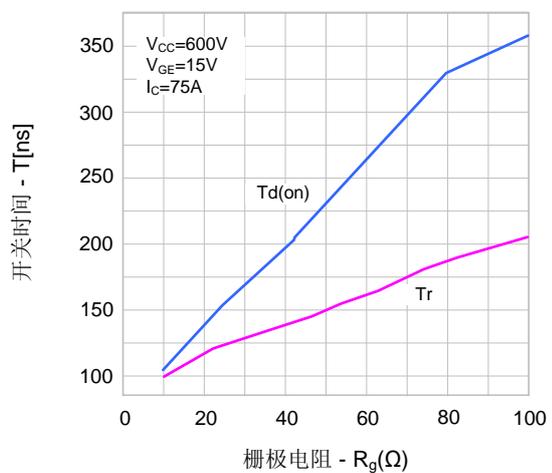


图6. 开启特性 vs. 栅极电阻



典型特性曲线 (续)

图7. 关断特性 vs. 栅极电阻

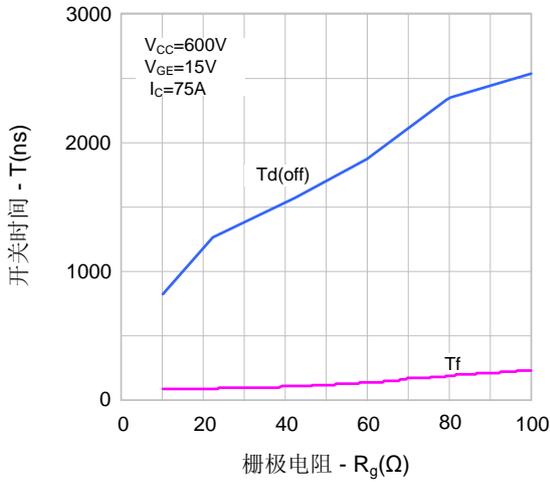


图8. 开关损耗 vs. 栅极电阻

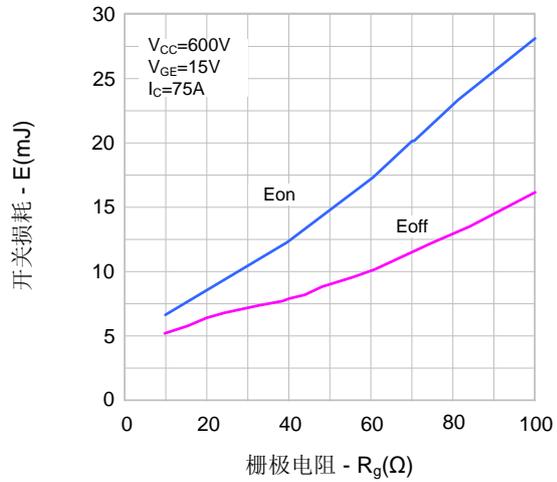


图9. 开启特性 vs. 集电极电流

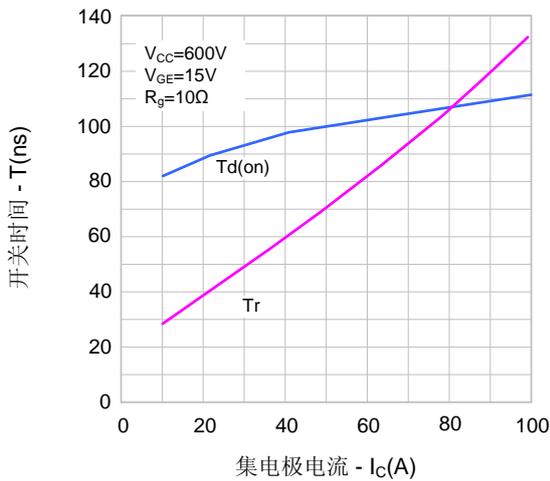


图10. 关断特性 vs. 集电极电流

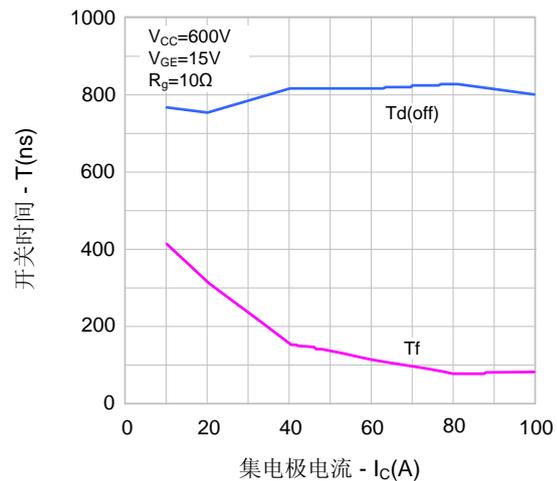


图 11. 开关损耗 vs. 集电极电流

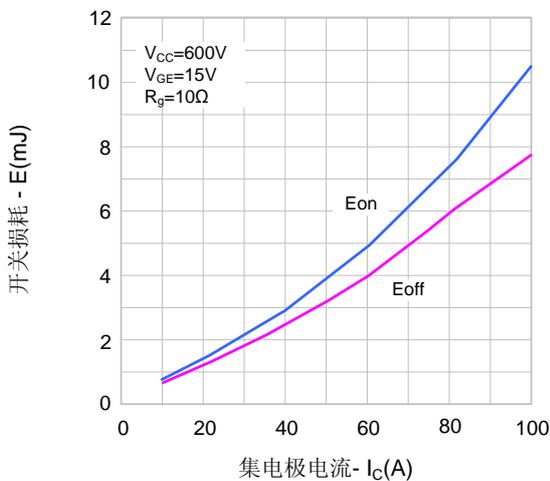
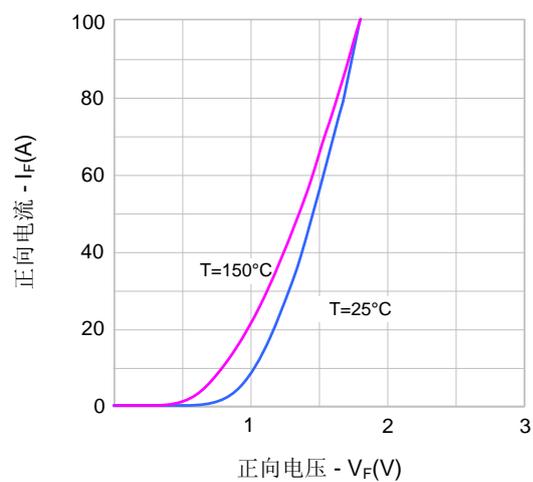
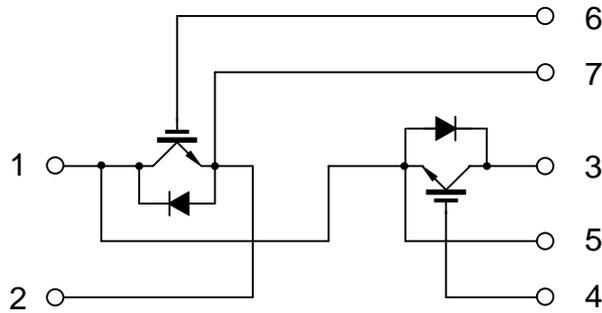


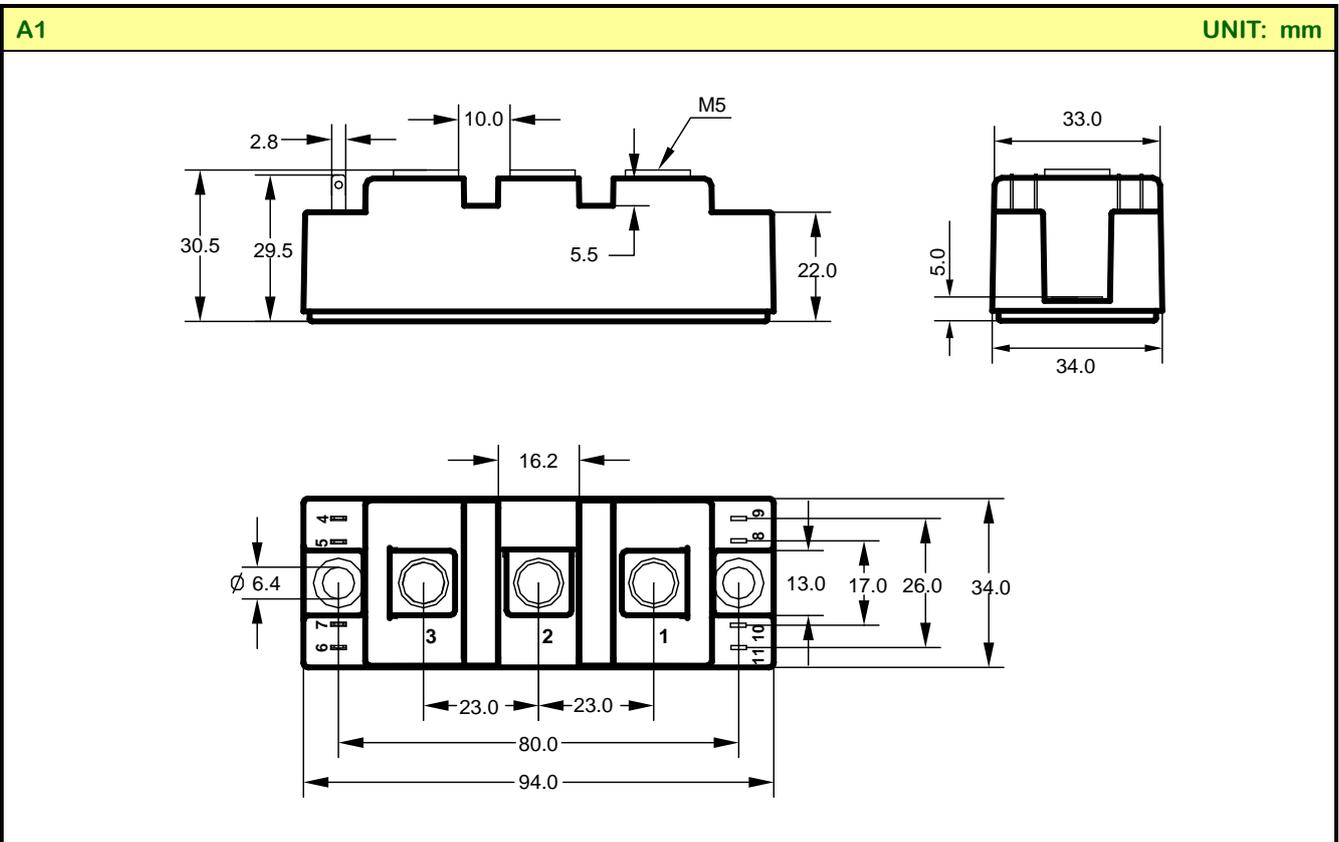
图 12. 二极管正向特性



电路图



封装外形图



声明:

- ◆ 士兰保留说明书的更改权, 恕不另行通知! 客户在下单前应获取最新版本资料, 并验证相关信息是否完整和最新。
- ◆ 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能, 买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!
- ◆ 产品提升永无止境, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!

产品名称: SGM75HF12A1TFD 文档类型: 说明书
版 权: 杭州士兰微电子股份有限公司 公司主页: <http://www.silan.com.cn>

版 本: 1.2 作 者: 殷资

修改记录:

1. 更新电参数

版 本: 1.1 作 者: 殷资

修改记录:

1. 修改 FRD 电气特性参数
2. 修改产品规格分类

版 本: 1.0 作 者: 殷资

修改记录:

1. 正式发布版本
-